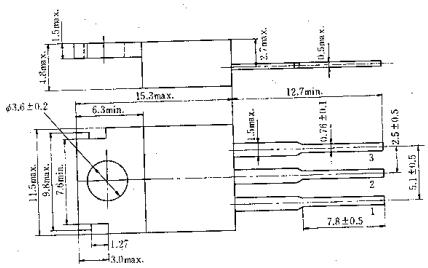
2SC1722

シリコン NPN 三重拡散 LTP 形

低周波電力増幅用
TV 水平，垂直励振用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED LTP

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
TV HORIZONTAL/VERTICAL DRIV.



1. ベース：Base
2. コレクタ：Collector
（フランジ）(Flange)
3. エミッタ：Emitter
(Dimensions in mm)

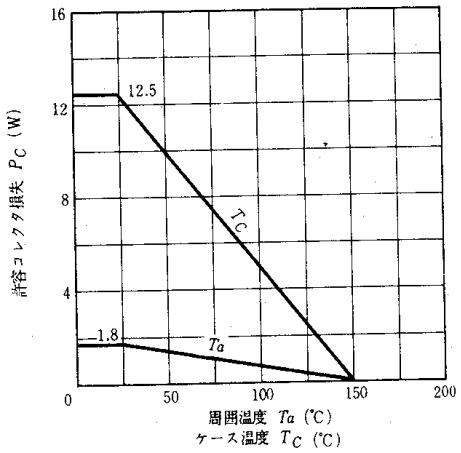
(JEDEC TO-220AB)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	2SC1722	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	300	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	300	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	0.2	A
許容コレクタ損失	P_C*	12.5	W
許容コレクタ損失	P_C	1.8	W
接合部温度	T_j	150	℃
保存温度	T_{stg}	−45～+150	℃

* T_C=25℃における許容値
* Value at T_C=25℃

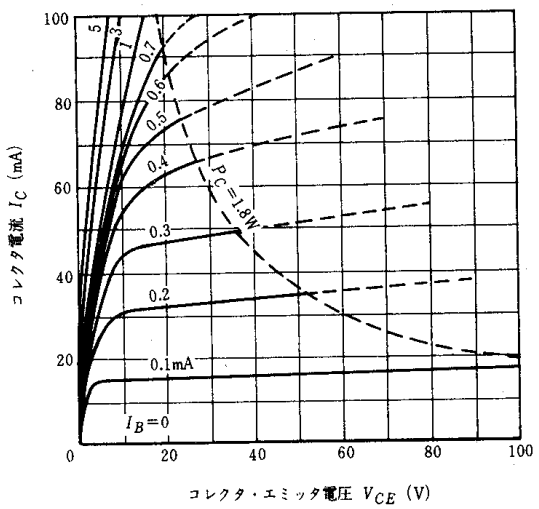
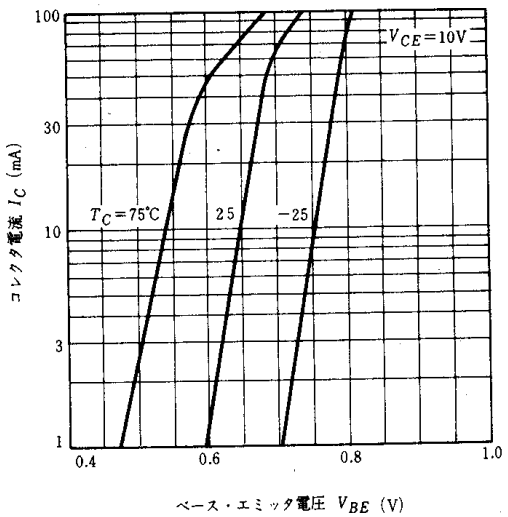
許容コレクタ損失の周囲温度，ケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	I_C=100μA, I_E=0	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	I_C=5mA, R_{BE}=∞	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	I_E=100μA, I_C=0	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	V_{CB}=250V, I_E=0	—	—	0.1	μA
	I_{CEO}	V_{CE}=250V, R_{BE}=∞	—	—	2	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=50mA	50	—	300	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	I_C=50mA, I_B=5mA	—	1.0	2.0	V
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	V_{CE}=10V, I_C=50mA	—	0.68	0.9	V
利得帯域幅積	f_T	V_{CE}=20V, I_C=30mA	—	80	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	V_{CB}=50V, I_E=0, f=1MHz	—	4.3	6.0	pF

エミッタ接地出力静特性
TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



エミッタ接地伝達静特性
TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS